

200-1100nm 放大型固定增益硅光电探测器



产品描述

我们的硅探测器，感光范围覆盖 200nm~1100nm，常用于紫外与可见光测量；放大型探测器，固定增益，定量化光电转换；具备足够增益的同时，保证高带宽性能，适用于光强弱、速度快的光电探测应用开发；索雷博 THORLABS 同款，无缝兼容；性能优秀，高性价比，quan 方位技术支持；提供非标定制服务。

产品特点

- 硅探测器，感光范围覆盖 200nm~1100nm，常用于紫外与可见光测量；
- 放大型探测器，固定增益，定量化光电转换；
- 具备足够增益的同时，保证高带宽性能，适用于光强弱、速度快的光电测应用开发；
- 索雷博 THORLABS 同款，无缝兼容；
- 性能优秀，高性价比，quan 方位技术支持；提供非标定制服务。

应用领域

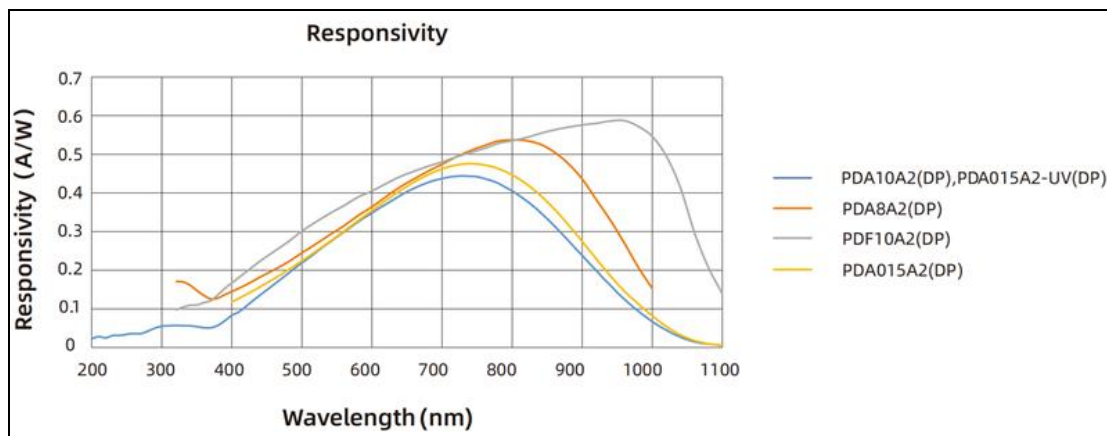
- 监控调 Q 激光器的输出
- 监控锁模激光器的输出

通用参数

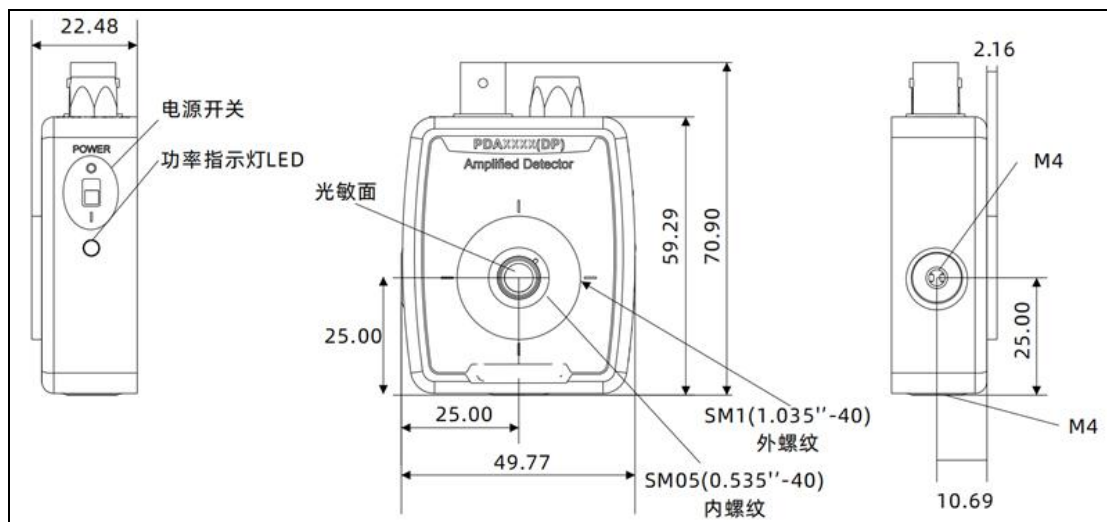
参数信息

产品型号	PDA10A2(DP)	PDA015A2-U V(DP)	PDA015A2(D P)	PDF10A2(DP)	PDA8A2(DP)
波长范围	200~1100nm		400~1000nm	320~1100nm	320~1000nm
感光尺寸	Φ1.0mm	Φ150μm		1.1m x 1.1mm	Φ0.8mm
带宽范围	DC~150MHz	DC~380MHz		DC~20Hz	DC~50MHz
增益 GAIN	Hi-Z 负载: 1 X 104 V/ A; 50Ω负载: 5 X 10 3 V/A	Hi-Z 负载: 5 X 104 V/A; 50 Ω负载: 2 .5 X 104 V/A		1 x 1012 V/A ±10%	Hi-Z 负载: 100kV/A; 50Ω负载: 50kV/A
信号幅值	Hi-Z 负载: 0~10V; 50 Ω负载: 0~5V	Hi-Z 负载: 0~10V; 50Ω负 载: 0~5V		0~10V	Hi-Z 负载: 0~3 .6V; 50Ω负载: 0~1.8V
NEP	2.92 X 10-11 W/Hz1/ 2	3.6 X 10-11 W/Hz1/2		3.0 X 10-15 W/Hz1/ 2	7.8 X 10-12 W/Hz1/2
光敏面深度	0.09" (2.2 mm)	0.20" (5.0 mm)		0.10" (2.4 mm)	0.07" (1.8 mm)
工作温度	10 ~ 50℃	10 ~ 40℃		10 ~ 50℃	
存储温度	-25 ~ 70℃				
探测器净重	0.1kg				0.06kg
外观尺寸	2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.8 mm X 22.5mm)			2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.9 mm X 22.5mm)	
供电接口	供电电源	供电开关	信号接口	支杆接口	光学接口
LUMBERG RSMV3 FE MALE	LDS12B(DP), ±12 VDC 稳压线性 电 源,6 W, 220VAC	滑动开关 带 LED 指示灯	BNC 母座	M4 X 2	SM1 X 1 SM0.5 X 1

响应曲线:



产品尺寸:



产品配置:



型号及订购

型号	感光范围	感光尺寸	固定增益(Hi-Z 负载)	带宽范围	特性
PDA10A2(DP)	200~ 1100nm	Φ1.0mm	1 X 10 ⁴ V/A	DC~150MHz	高速带增益 ,适用于快速弱光测量
PDA015A2-UV(DP)	200~ 1100nm	Φ150μm	5 X 10 ⁴ V/A	DC~380MHz	
PDA015A2(DP)	400~ 1000nm	Φ150μm	5 X 10 ⁴ V/A	DC~380MHz	
PDF10A2(DP)	320~ 1100nm	1.1m x 1.1mm	1 X 10 ¹² V/A ±10%	DC~20Hz	极弱光 (fW) 测量
PDA8A2(DP)	320~ 1000nm	Φ0.8mm	100kV/A	DC~50MHz	参数平衡